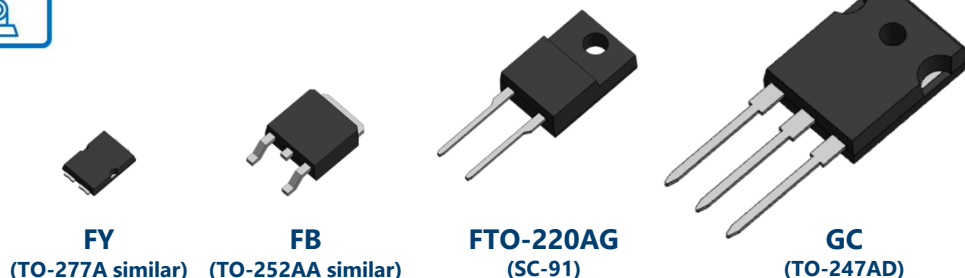


低VF・低損失 SiCショットキーバリアダイオード



面実装型パッケージ

Part Name	絶対最大定格 (T _C =25°C)					電氣的・熱的特性 (T _C =25°C)				Package	Status
	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	I _{F(AV)} [A]	V _{RRM} [V]	I _{FSM} [A]	V _F typ [V]	I _R max ^{*1} [uA]	trr/Qrr typ [ns]/[nC]	R _{th(j-c)} max [°C/W]		
WS6FY65BK	-55~175	-55~175	6	650	T.B.D.	1.35 (I _F =6A)	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.	FY	Planning
WS10FY65AK	-55~175	-55~175	10	650	50	1.49 (I _F =10A)	50	6 / 5	T.B.D.	FY	RS
WS6FB65BK	-55~175	-55~175	6	650	T.B.D.	1.35 (I _F =6A)	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.	FB	Planning
WS10FB65AK	-55~175	-55~175	10	650	50	1.49 (I _F =10A)	50	6 / 5	T.B.D.	FB	RS
WS20FBC65AK	-55~175	-55~175	20	650	50	1.49 (I _F =10A) ^{*3}	50 ^{*3}	6 / 5 ^{*3}	T.B.D.	FB	RS ^{*4}
WS20FB65AK	-55~175	-55~175	20	650	90	1.47 (I _F =20A)	400	8 / 10	T.B.D.	FB	RS ^{*4}

*1 : V_R=650V *3 : per diode
*2 : V_R=1200V *4 : 2024/2Q

挿入型パッケージ

Part Name	絶対最大定格 (T _C =25°C)					電氣的・熱的特性 (T _C =25°C)				Package	Status
	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	I _{F(AV)} [A]	V _{RRM} [V]	I _{FSM} [A]	V _F typ [V]	I _R max ^{*1} [uA]	trr/Qrr typ [ns]/[nC]	R _{th(j-c)} max [°C/W]		
WS10SF65AK	-55~175	-55~175	10	650	50	1.49 (I _F =10A)	50 ^{*1}	6 / 5	T.B.D.	FTO-220AG	RS
WS20SF65AK	-55~175	-55~175	20	650	90	1.47 (I _F =20A)	400 ^{*1}	8 / 10	T.B.D.	FTO-220AG	Planning
WS10SF120AK	-55~175	-55~175	10	1200	90	1.48 (I _F =10A)	200 ^{*2}	8 / 10	T.B.D.	FTO-220AG	RS
WS20GC65AK	-55~175	-55~175	20	650	90	1.47 (I _F =20A)	400 ^{*1}	8 / 10	T.B.D.	GC	RS ^{*5}
WS20GCC65AK	-55~175	-55~175	20	650	50	1.49 (I _F =10A) ^{*3}	50 ^{*1} ^{*3}	6 / 5 ^{*3}	T.B.D.	GC	RS
WS40GCC65AK	-55~175	-55~175	40	650	90	1.47 (I _F =20A) ^{*3}	400 ^{*1} ^{*3}	8 / 10 ^{*3}	T.B.D.	GC	RS ^{*5}
WS10GC120AK	-55~175	-55~175	10	1200	90	1.48 (I _F =10A)	200 ^{*2}	8 / 10	T.B.D.	GC	RS
WS20GCC120AK	-55~175	-55~175	20	1200	90	1.48 (I _F =10A) ^{*3}	200 ^{*2} ^{*3}	8 / 10 ^{*3}	T.B.D.	GC	RS

*1 : V_R=650V *4 : 2024/2Q
*2 : V_R=1200V *5 : 2024/3Q
*3 : per diode

新電元半導体製品の詳細情報はこちら
<https://www.shindengen.co.jp/products/semi/>

